

(19) 日本国特許庁(JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2008-166258  
(P2008-166258A)

(43) 公開日 平成20年7月17日(2008.7.17)

(51) Int.Cl.	F 1		テーマコード (参考)
<b>H05B 33/22</b> (2006.01)	H05B 33/22	Z	3K107
<b>G09F 9/30</b> (2006.01)	G09F 9/30	338	5C094
<b>H01L 27/32</b> (2006.01)	G09F 9/30	365Z	
<b>H05B 33/28</b> (2006.01)	G09F 9/30	349Z	
<b>H05B 33/26</b> (2006.01)	H05B 33/28		

審査請求 有 請求項の数 23 O L (全 25 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号	特願2007-271736 (P2007-271736)	(71) 出願人	590002817 三星エスディアイ株式会社 大韓民国京畿道水原市靈通区▲しん▼洞5 75番地
(22) 出願日	平成19年10月18日 (2007.10.18)	(74) 代理人	100089037 弁理士 渡邊 隆
(31) 優先権主張番号	10-2007-0001027	(74) 代理人	100064908 弁理士 志賀 正武
(32) 優先日	平成19年1月4日 (2007.1.4)	(74) 代理人	100108453 弁理士 村山 靖彦
(33) 優先権主張国	韓国 (KR)	(72) 発明者	大韓民国京畿道水原市靈通區▲シン▼洞5 75番地 三星エスディアイ株式会社内 權 正鉉

最終頁に続く

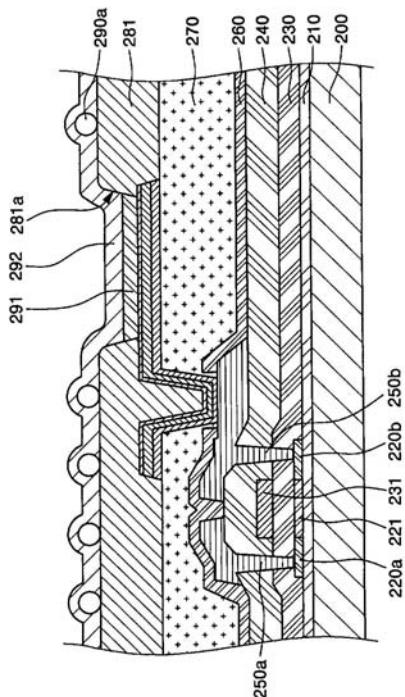
(54) 【発明の名称】有機電界発光表示装置及びその製造方法

## (57) 【要約】

【課題】スペーサパターンを形成するための写真エッチング工程を排除する有機電界発光表示装置及びその製造方法を提供する。

【解決手段】本発明は、基板と；前記基板上に位置する第1電極と；前記第1電極上に位置し且つ開口部及び非開口部を有する画素定義膜と；前記画素定義膜の非開口部に位置する多数のポール状スペーサと；前記第1電極の上部に位置し且つ発光層を含む有機膜層と；前記有機膜層の上部に位置する第2電極と；を備える有機電界発光表示装置を提供する。また、本発明は、基板を用意し；前記基板の上部に第1電極を形成し；前記第1電極の上部に画素定義膜を形成し；前記画素定義膜の上部にポール状スペーサを塗布し；第1電極の一部を露出させ発光領域を定義する開口部を形成し；前記第1電極の上部に位置し且つ発光層を含む有機膜層を形成し；前記有機膜層の上部に第2電極を形成する；ことを含む有機電界発光表示装置の製造方法を提供する。

【選択図】図4 e



## 【特許請求の範囲】

## 【請求項 1】

基板と、

前記基板上に位置する第1電極と、

前記第1電極上に位置し、且つ開口部及び非開口部を有する画素定義膜と、

前記画素定義膜の非開口部に位置する多数のボール状スペーサと、

前記第1電極の上部に位置し、且つ発光層を含む有機膜層と、

前記有機膜層の上部に位置する第2電極と、を備えることを特徴とする有機電界発光表示装置。

## 【請求項 2】

前記画素定義膜は、ポリアクリル系樹脂 (polyacrylates resin)、エポキシ樹脂 (epoxy resin)、フェノール樹脂 (phenolic resin)、ポリアミド系樹脂 (polyamides resin)、ポリイミド系樹脂 (polyimides resin)、不飽和ポリエステル系樹脂 (unsaturated polyesters resin)、ポリフェニレン系樹脂 (poly(phenylene ethers) resin)、ポリフェニレンスルファイド系樹脂 (poly(phenylenesulfides) resin) 及びベンゾシクロブテン (benzocyclobutene; BCB) よりなる群から選択された1つの物質で形成されることを特徴とする請求項1に記載の有機電界発光表示装置。

## 【請求項 3】

前記第1電極は、ITO (Indium Tin Oxide)、IZO (Indium Zinc Oxide)、TO (Tin Oxide) 及びZnO (Zinc Oxide) よりなる群から選択される1つの物質からなり、前記第2電極は、Li、Ca、LiF/Ca、LiF/Al、Al、Mg 及びこれらの合金よりなる群から選択されるいすれか1つの物質からなることを特徴とする請求項1に記載の有機電界発光表示装置。

## 【請求項 4】

前記第1電極は、Ag、Mg、Al、Pt、Pd、Au、Ni、Nd、Ir、Cr 及びこれらの化合物よりなる群から選択されるいすれか1つの物質で反射膜を形成した後、前記反射膜の上部に、ITO (Indium Tin Oxide)、IZO (Indium Zinc Oxide)、TO (Tin Oxide) 及びZnO (Zinc Oxide) よりなる群から選択される1つの物質からなる透明電極を形成した積層構造となっており、前記第2電極は、Li、Ca、LiF/Ca、LiF/Al、Al、Mg 及びMg合金よりなる群から選択される1つの物質からなることを特徴とする請求項1に記載の有機電界発光表示装置。

## 【請求項 5】

前記第2電極は、5乃至30nmの厚さであることを特徴とする請求項4に記載の有機電界発光表示装置。

## 【請求項 6】

前記基板上にソース／ドレイン領域を有する半導体層と、前記半導体層に電気的に連結されるソース／ドレイン電極を有する薄膜トランジスタとをさらに備え、

前記ソース／ドレイン電極のいすれか1つは、前記第1電極に連結されることを特徴とする請求項1に記載の有機電界発光表示装置。

## 【請求項 7】

基板と、

前記基板上にソース／ドレイン領域を有する半導体層、及び前記半導体層に電気的に連結されるソース／ドレイン電極を有する薄膜トランジスタと、

前記ソース／ドレイン電極のいすれか1つに連結され、且つ下部電極層、反射電極層及び上部電極層の積層構造からなる第1電極と、

前記第1電極上に位置し、且つ開口部及び非開口部を有する画素定義膜と、

前記画素定義膜の非開口部に位置する多数のボール状スペーサと、

10

20

30

40

50

前記第1電極の上部に位置し、且つ発光層を含む有機膜層と、  
前記有機膜層の上部に位置する第2電極と、を備えることを特徴とする有機電界発光表示装置。

#### 【請求項8】

前記画素定義膜は、ポリアクリル系樹脂(polyacrylates resin)、エポキシ樹脂(epoxy resin)、フェノール樹脂(phenolic resin)、ポリアミド系樹脂(polyamides resin)、ポリイミド系樹脂(polyimides resin)、不飽和ポリエステル系樹脂(unsatuated polyesters resin)、ポリフェニレン系樹脂(poly(phenylene ethers) resin)、ポリフェニレンスルファイド系樹脂(poly(phenylenesulfides) resin)及びベンゾシクロブテン(benzocyclobutene、BCB)よりなる群から選択された1つの物質で形成されることを特徴とする請求項7に記載の有機電界発光表示装置。10

#### 【請求項9】

前記下部電極層は、ITO(Indium Tin Oxide)、IZO(Indium Zinc Oxide)、TO(Tin Oxide)及びZnO(Zinc Oxide)よりなる群から選択される1つの物質からなることを特徴とする請求項7に記載の有機電界発光表示装置。20

#### 【請求項10】

前記反射電極層は、Al、Al合金、Ag及びAg合金よりなる群から選択される1つの物質からなることを特徴とする請求項7に記載の有機電界発光表示装置。20

#### 【請求項11】

前記上部電極層は、ITO(Indium Tin Oxide)、IZO(Indium Zinc Oxide)、TO(Tin Oxide)及びZnO(Zinc Oxide)よりなる群から選択される1つの物質からなることを特徴とする請求項7に記載の有機電界発光表示装置。20

#### 【請求項12】

前記下部電極層は、50～100の厚さを有することを特徴とする請求項7に記載の有機電界発光表示装置。20

#### 【請求項13】

前記反射電極層は、900～2000の厚さを有することを特徴とする請求項7に記載の有機電界発光表示装置。30

#### 【請求項14】

前記上部電極層は、50～100の厚さを有することを特徴とする請求項7に記載の有機電界発光表示装置。30

#### 【請求項15】

基板を用意し、

前記基板の上部に第1電極を形成し、

前記第1電極の上部に画素定義膜を形成し、

前記画素定義膜の上部に多数のボール状スペーサを塗布し、40

前記画素定義膜上に第1電極の一部を露出させ且つ発光領域を定義する開口部を形成し、

前記第1電極の上部に位置し且つ発光層を含む有機膜層を形成し、

前記有機膜層の上部に第2電極を形成することを備えることを特徴とする有機電界発光表示装置の製造方法。40

#### 【請求項16】

前記画素定義膜を形成した後に、画素定義膜上に開口部を形成するために画素定義膜を露光する工程をさらに備えることを特徴とする請求項15に記載の有機電界発光表示装置の製造方法。50

#### 【請求項17】

前記画素定義膜を露光する工程は、シャドウマスクを用いることを特徴とする請求項 16 に記載の有機電界発光表示装置の製造方法。

**【請求項 18】**

前記シャドウマスクは、前記画素定義膜が陽性 (positive) 材料物質である場合には、開口部として予定される部分が透過領域であり、開口部以外の領域が遮断領域であることを特徴とする請求項 17 に記載の有機電界発光表示装置の製造方法。

**【請求項 19】**

前記シャドウマスクは、前記画素定義膜が陰性 (negative) 材料物質である場合には、開口部として予定される部分が遮断領域であり、開口部以外の領域が透過領域であることを特徴とする請求項 17 に記載の有機電界発光表示装置の製造方法。

10

**【請求項 20】**

前記ボール状スペーサを塗布した後に、ボール状スペーサを含む基板をベークする工程をさらに備えることを特徴とする請求項 15 に記載の有機電界発光表示装置の製造方法。

**【請求項 21】**

前記有機膜層を形成することは、蒸着用マスクを用いることを特徴とする請求項 15 に記載の有機電界発光表示装置の製造方法。

**【請求項 22】**

前記スペーサを塗布することは、スペーサディスペンサを用いることを特徴とする請求項 15 に記載の有機電界発光表示装置の製造方法。

20

**【請求項 23】**

前記基板上にソース / ドレイン領域を有する半導体層と、前記半導体層に電気的に連結されるソース / ドレイン電極を有する薄膜トランジスタとをさらに形成し、

前記ソース / ドレイン電極のいずれか 1 つは、前記第 1 電極に連結されることを特徴とする請求項 15 に記載の有機電界発光表示装置の製造方法。

**【発明の詳細な説明】**

**【技術分野】**

**【0001】**

本発明は、蒸着マスクを用いて発光層を含む有機膜層を形成する際に、画素定義膜の上部に位置するボール状スペーサを使用して、蒸着マスクの凹凸による画素定義膜などの損傷を防止するための有機電界発光表示装置及びその製造方法に関する。

30

**【背景技術】**

**【0002】**

一般的に、有機電界発光素子は、ITO のような透明電極である第 1 電極 (anode) と、仕事関数が低い金属 (Ca, Li, Al など) を使用した第 2 電極 (cathode) との間に有機膜層が介設される構造で構成される。このような有機電界発光素子に順方向の電圧を印加する場合、陽極及び陰極において各々正孔 (hole) と電子 (electron) とが結合し、励起子 (exciton) を形成し、励起子が発光再結合して電気発光現象を起こす。

**【0003】**

前記第 1 電極は、反射型、すなわち光を反射するように形成し、前記第 2 電極は、透過型、すなわち光を透過するように形成することによって、前記有機膜層から放出される光を前記第 2 電極方向に放出させる有機電界発光素子を製造することができる。

40

**【0004】**

この際、前記有機膜層は、様々な方法で形成することができ、それらのうち 1 つの方法が蒸着であり、前記蒸着方法を用いて有機電界発光表示装置を製作するためには、薄膜などが形成される面に、薄膜などのパターンと同じパターンを有するマスクを密着させ、薄膜などの材料を蒸着し、所定パターンの薄膜を形成する。

**【0005】**

図 1 は、蒸着用マスクを具備した蒸着装置を概略的に示す断面図である。

図 1 を参照すれば、マスク 1 を用いて有機電界発光表示装置の薄膜、すなわち発光層を

50

含む有機膜層を蒸着するためには、真空チャンバー2に設置された薄膜蒸着容器(c r u c i b l e)3と対応する側にマスクに結合されたフレーム4を設置し、フレーム4の上部に薄膜などが形成される対象物5を装着する。そして、対象物5の上部には、フレーム4に支持されたマスク1を薄膜などが形成される対象物5に密着させるためのマグネットユニット6を駆動させて、前記マスク1を前記薄膜などが形成される対象物5に密着する。この状態で、前記薄膜蒸着容器3を作動することによって、薄膜蒸着容器3に装着された物質が前記対象物5に蒸着される。

#### 【0006】

しかし、前記マスク1の表面には、2~3μmの凹凸が形成されていて、前記マスク1と薄膜などが形成される対象物5とが密着されているので、前記マスク1の凹凸に起因して対象物5の薄膜、例えば、画素定義膜にスクラッチ(s c r a t c h)を与える。これを防止するために対象物5とマスク1の表面との間にスペーサ構造物を形成する。

10

#### 【0007】

図2a及び図2bは、従来の有機電界発光表示装置の製造方法を説明する断面図である。

#### 【0008】

図2aに示されたように、有機電界発光表示装置は、基板100上に形成されたバッファ層110と、前記バッファ層110上に形成されたソース/ドレイン領域120a、120b及びチャネル領域121からなる半導体層と、ゲート絶縁膜130上に形成されたゲート電極131と、層間絶縁膜140上に形成され、且つコンタクトホールを介して各々ソース/ドレイン領域120a、120bに電気的に連結されるソース/ドレイン電極150a、150bと、を備える。

20

#### 【0009】

一方、前記基板100上には、有機電界発光素子が形成される。前記有機電界発光素子は、薄膜トランジスタの上部に形成されている保護膜160及び平坦化膜170上に形成され、ピアホールを介して前記ドレイン電極150bに電気的に連結されるアノードとしての第1電極180と、前記第1電極の一定領域を露出させ、画素を定義する開口部を含む画素定義膜190とが形成される。

#### 【0010】

また、前記画素定義膜190上にスペーサフィルムをコートし、前記スペーサフィルムの上部にフォトレジスト膜(不図示)を形成し、前記フォトレジスト膜(不図示)をシャドウマスクを用いて露光及び現像することによって、フォトレジストパターン(不図示)を形成した後、前記フォトレジストパターン(不図示)をマスクとして用いて前記スペーサフィルムをパターニングし、スペーサパターン191を形成する。

30

#### 【0011】

次に、図2bに示されたように、前述のような蒸着用マスクを具備した蒸着装置を用いて発光層を含む有機膜層192を形成する。また、スパッタリングなどの方法を用いて前記有機膜層192の上部に第2電極193を形成する。この際に、蒸着装置を用いて有機膜層を形成する際に、前記スペーサパターンは、前記蒸着用マスクが前記画素定義膜が形成された基板上に密着されて生じる蒸着用マスクの凹凸に起因して画素定義膜などが損傷されることを防止する役目をする。

40

#### 【0012】

しかしながら、前述のような従来の有機電界発光表示装置は、スペーサパターンを形成するための写真エッチング(photo lithography)工程が1回追加され、また、スペーサフィルムの形成による材料コストが上昇するので、量産性を低下させるという問題点がある。

#### 【0013】

また、前述のような従来の有機電界発光表示装置は、写真エッチング工程によってスペーサフィルムをパターニングし、前述のようなスペーサパターンを形成するので、前記第1電極にスペーサフィルムの残膜が残って有機電界発光素子の性能を低下させるという問

50

題点がある。

【特許文献1】大韓民国特許公開第10-2006-4476号明細書

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0014】

従って、本発明は、前述のような従来技術の諸問題点を解決するためになされたもので、その目的は、蒸着マスクを用いて発光層を含む有機膜層を形成する際に、画素定義膜の上部に位置するボール状スペーサを使用して、蒸着マスクの凹凸による画素定義膜などの損傷を防止することによって、従来のスペーサパターンを形成するための写真エッチング工程を排除する有機電界発光表示装置及びその製造方法を提供することにある。 10

【課題を解決するための手段】

【0015】

上記目的を達成するために、本発明の一態様に係る有機電界発光表示装置は、基板と、前記基板上に位置する第1電極と、前記第1電極上に位置し、且つ開口部及び非開口部を有する画素定義膜と、前記画素定義膜の非開口部に位置する多数のボール状スペーサと、前記第1電極の上部に位置し、且つ発光層を含む有機膜層と、前記有機膜層の上部に位置する第2電極と、を備えることを特徴とする。

【0016】

また、本発明に係る有機電界発光表示装置は、前記基板上にソース／ドレイン領域を有する半導体層と、前記半導体層に電気的に連結されるソース／ドレイン電極を有する薄膜トランジスタとをさらに備え、前記ソース／ドレイン電極のいずれか1つは、前記第1電極に連結されることを特徴とする。 20

【0017】

また、本発明の他の態様に係る有機電界発光表示装置は、基板と、前記基板上にソース／ドレイン領域を有する半導体層、及び前記半導体層に電気的に連結されるソース／ドレイン電極を有する薄膜トランジスタと、前記ソース／ドレイン電極のいずれか1つに連結され、且つ下部電極層、反射電極層及び上部電極層の積層構造からなる第1電極と、前記第1電極上に位置し、且つ開口部及び非開口部を有する画素定義膜と、前記画素定義膜の非開口部に位置する多数のボール状スペーサと、前記第1電極の上部に位置し、且つ発光層を含む有機膜層と、前記有機膜層の上部に位置する第2電極と、を備えることを特徴とする。 30

【0018】

また、本発明のさらに他の態様に係る有機電界発光表示装置の製造方法は、基板を用意し；前記基板の上部に第1電極を形成し；前記第1電極の上部に画素定義膜を形成し；前記画素定義膜の上部に多数のボール状スペーサを塗布し；前記画素定義膜上に第1電極の一部を露出させ且つ発光領域を定義する開口部を形成し；前記第1電極の上部に位置し且つ発光層を含む有機膜層を形成し；前記有機膜層の上部に第2電極を形成することを備えることを特徴とする。

【0019】

また、本発明に係る有機電界発光表示装置の製造方法は、前記基板上にソース／ドレイン領域を有する半導体層と、前記半導体層に電気的に連結されるソース／ドレイン電極を有する薄膜トランジスタとをさらに形成し、前記ソース／ドレイン電極のいずれか1つは、前記第1電極に連結されることを特徴とする。 40

【0020】

また、本発明に係る有機電界発光表示装置の製造方法は、前記画素定義膜を形成した後に、画素定義膜上に開口部を形成するために画素定義膜を露光する工程をさらに備えることを特徴とする。

【0021】

また、本発明に係る有機電界発光表示装置の製造方法は、前記ボール状スペーサを塗布した後に、ボール状スペーサを含む基板をベークする工程をさらに備えることを特徴とす 50

る。

【0022】

また、本発明に係る有機電界発光表示装置の製造方法は、前記有機膜層を形成することは、蒸着用マスクを用いることを特徴とする。

【発明の効果】

【0023】

従って、本発明に係る有機電界発光表示装置は、蒸着マスクを用いて発光層を含む有機膜層を形成する際に、画素定義膜の上部に位置するポール状スペーサを使用して、蒸着マスクの凹凸による画素定義膜などの損傷を防止することによって、従来のスペーサパターンを形成するための工程を排除する効果を奏する。

10

【0024】

また、本発明に係る有機電界発光表示装置は、前記スペーサパターンを形成するための工程を排除するので、スペーサパターンを形成するための写真エッチング工程を低減することができ、スペーサフィルムの形成による材料コストの上昇を防止する効果を奏する。

【0025】

また、本発明に係る有機電界発光表示装置は、スペーサフィルムのパターン工程を排除するので、第1電極上にスペーサフィルムの残膜が残って有機電界発光素子の性能を低下させる問題点を解決する効果を奏する。

20

【発明を実施するための最良の形態】

【0026】

以下、添付の図面を参照して、本発明の好適な実施形態を詳細に説明する。下記の実施形態は、当業者に本発明の思想が十分に伝達され得るようにするために一例として提示されるものである。したがって、本発明は、下記の実施形態に限らず、様々な変形が可能である。なお、図面において、層及び領域の長さ、厚みなどは、明確性を図るために誇張されたものである。本明細書において、同一の参照番号は、同一の構成要素を示す。

【0027】

図3は、有機電界発光表示装置の単位画素を示す平面図である。

図3に示されたように、1つの単位画素には、スイッチングトランジスタTr1、駆動トランジスタTr2、キャパシタ40、及び有機発光ダイオード50が形成され、信号によって光が放出される。また、ゲートライン10とデータライン20及び電源供給ライン30が各素子に連結される。

30

【0028】

前記スイッチングトランジスタTr1は、ゲートライン10に印加されるスキャン信号により駆動され、データライン20に印加されるデータ信号を駆動トランジスタTr2に伝達する役目をする。

【0029】

前記駆動トランジスタTr2は、前記スイッチングトランジスタTr1から伝達されたデータ信号と電源供給ライン30から伝達された信号、すなわちゲートとソース間の電圧差により有機発光ダイオード50を介して流れる電流量を決定する。

40

【0030】

また、前記キャパシタ40は、前記スイッチングトランジスタTr1を介して伝達されたデータ信号を1フレームの間に格納する役目をする。

【0031】

図4a乃至図4eは、本発明の実行例に係る有機電界発光表示装置の製造方法を示す断面図である。

【0032】

図4aに示されたように、透明絶縁基板200の全面にシリコン酸化物をプラズマ・強化化学気相蒸着(plasma-enhanced chemical vapor deposition; PECD)方法で所定の厚さを有するバッファ層210を形成する。この際、前記バッファ層210は、後続工程で形成される非晶質シリコン層の結晶化工

50

程の際、前記透明絶縁基板 200 内の不純物が拡散されることを防止する。

【0033】

前記バッファ層 210 の上部に半導体層である非晶質シリコン層（図示せず）を所定の厚さで蒸着する。次に、前記非晶質シリコン層を E L A (Excimer Laser Annealing)、S L S (Sequential Lateral Solidification)、M I C (Metal Induced Crystallization) または M I L C (Metal Induced Lateral Crystallization) 法などを用いて結晶化し、写真エッチング工程でパターニングし、単位画素内の半導体層パターンを形成する。

【0034】

前記半導体層パターンを含む基板の全面にゲート絶縁膜 230 を形成する。この際に、前記ゲート絶縁膜 230 は、シリコン酸化膜 ( $\text{SiO}_2$ )、シリコン窒化膜 ( $\text{SiN}_x$ ) またはこれらの二重層で形成することができる。

【0035】

前記ゲート絶縁膜 230 上の、前記半導体層パターンのチャネル領域 221 に対応する一定領域にゲート電極 231 を形成する。前記ゲート電極 231 は、アルミニウム (Al)、アルミニウム合金 (Al-alloy)、モリブデン (Mo) 及びモリブデン合金 (Mo-alloy) よりなる群から選択される 1 つの物質で形成することができる。

【0036】

次に、前記ゲート電極 231 をイオン注入マスクとして用いて前記半導体層パターン 20 に不純物をイオン注入し、ソース / ドレイン領域 220a、220b を形成する。この際に、前記イオン注入工程は、n+ または p+ 不純物をドーパントとして用いて行われる。

【0037】

次に、全体表面の上部に所定の厚さを有する層間絶縁膜 240 を形成する。この際に、前記層間絶縁膜 240 は、シリコン酸化膜 ( $\text{SiO}_2$ )、シリコン窒化膜 ( $\text{SiN}_x$ ) またはこれらの二重層で形成することができる。

【0038】

次に、写真エッチング工程で前記層間絶縁膜 240 及びゲート絶縁膜 230 をエッチングし、前記ソース / ドレイン領域 220a、220b を露出させるコンタクトホールを形成する。

【0039】

次に、前記コンタクトホールを含む全体表面の上部にソース / ドレイン電極物質を形成し、写真エッチング工程で前記ソース / ドレイン電極物質をエッチングし、前記ソース / ドレイン領域 220a、220b に接続されるソース / ドレイン電極 250a、250b を形成する。この際に、前記ソース / ドレイン電極 250a、250b を形成する際に、前記ソース / ドレイン電極物質として、Mo、W、MoW、AlNd、Ti、Al、Al 合金、Ag 及び Ag 合金などよりなる群から選択される 1 つの物質を使用して单一層で形成したり、配線抵抗を低減するために低抵抗物質である Mo、Al または Ag の 2 層構造またはそれ以上の多重膜構造、すなわち Mo / Al / Mo、MoW / Al - Nd / MoW、Ti / Al / Ti、Mo / Ag / Mo 及び Mo / Ag - 合金 / Mo などよりなる群から選択される 1 つの積層構造で形成する。

【0040】

前記ソース / ドレイン電極 250a、250b の上部には、絶縁膜が位置し、前記絶縁膜は、無機膜 260、有機膜 270 またはこれらの二重層であることができる。また、前記絶縁膜上には、前記絶縁膜内のビアホールを介して連結される第 1 電極層 280 が位置する。

【0041】

前記第 1 電極層 280 は、背面発光型の場合には、透明電極として備えられることができ、前面発光型の場合には、反射型電極として備えられることができる。前記第 1 電極層

10

20

30

40

50

が透明電極として使われる場合には、ITO (Indium Tin Oxide)、IZO (Indium Zinc Oxide)、TO (Tin Oxide) 及びZnO (Zinc Oxide) よりなる群から選択される1つの物質で形成することができ、反射型電極として使われる場合には、Ag、Mg、Al、Pt、Pd、Au、Ni、Nd、Ir、Cr及びこれらの化合物よりなる群から選択されるいずれか1つの物質で反射膜を形成した後、その上にITO (Indium Tin Oxide)、IZO (Indium Zinc Oxide)、TO (Tin Oxide) 及びZnO (Zinc Oxide) よりなる群から選択される1つの物質を使用して透明電極を積層することによって形成することができる。

## 【0042】

10

また、前記第1電極層280は、前面発光型の場合に、下部電極層280a、反射電極層280b及び上部電極層280cの積層構造で形成することができる。

## 【0043】

前記下部電極層280aは、ITO (Indium Tin Oxide)、IZO (Indium Zinc Oxide)、TO (Tin Oxide) 及びZnO (Zinc Oxide) よりなる群から選択される1つの物質で形成することができる。この際に、前記下部電極層280aは、50乃至100の厚さを有するように形成する。前記下部電極層280aの厚さが50以下である場合、均一度の確保が難しく、100以上である場合、下部電極層の自体ストレスに起因して接着力が弱くなる。

## 【0044】

20

前記反射電極層280bは、Al、Al合金、Ag及びAg合金などよりなる群から選択される1つの物質を使用して形成することができ、この際に、反射電極層280bの厚さは、900~2000で形成することができる。厚さが900以下である場合、光の一部が透過するようになり、約1000が光が透過しない最小の厚さである。また、2000以上である場合、コストや工程時間などの観点から好ましくない。

## 【0045】

この際に、前記反射電極層280bは、光反射の役目をするので、輝度や光効率を増加させることができる。

## 【0046】

30

前記上部電極層280cは、ITO (Indium Tin Oxide)、IZO (Indium Zinc Oxide)、TO (Tin Oxide) 及びZnO (Zinc Oxide) よりなる群から選択される1つの物質で形成することができる。この際に、前記上部電極層280cの厚さは、50~100で形成する。前記上部電極層280cの厚さが50以下である場合、薄膜の均一度を保証することができず、100以上である場合、干渉効果に起因してブルー領域において特に反射率が10%~15%以上低くなる。

## 【0047】

次に、前記第1電極280上に絶縁膜を形成する。この際に、前記絶縁膜は、画素定義膜(pixel defined layer)281であることができる。

## 【0048】

40

前記画素定義膜281は、ポリアクリル系樹脂(polyacrylates resin)、エポキシ樹脂(epoxy resin)、フェノール樹脂(phenolic resin)、ポリアミド系樹脂(polyamides resin)、ポリイミド系樹脂(polyimides resin)、不飽和ポリエステル系樹脂(unsatuated polyesters resin)、ポリフェニレン系樹脂(polyphenylenes)、ポリフェニレンスルファイド系樹脂(polyphenylene sulfides resin)及びベンゾシクロブテン(benzocyclobutene、BCB)よりなる群から選択された1つの物質で形成することができる。

## 【0049】

50

この際に、前記画素定義膜 281は、陽性 (positive) 材料物質または陰性 (negative) 材料物質からなることができる。

#### 【0050】

前記陽性材料物質の場合、写真エッチング (photolithography) 工程で光の照射を受けた部分の構造が弱くなり (softening)、現像工程時に光の照射を受けた部分が除去される物質であり、前記陰性材料物質の場合、写真エッチング工程で光の照射を受けた部分の構造が強くなり (hardening)、現像工程時に光の照射を受けていない部分が除去される物質である。

#### 【0051】

次に、前記画素定義膜 281上に第1電極の一定領域を露出させ、発光領域を定義する開口部を形成するための写真エッチング工程を実行する。 10

#### 【0052】

図4bに示されたように、前記写真エッチング工程は、まず、シャドウマスク 282を用いて前記画素定義膜を露光 (expose) する。

#### 【0053】

この際に、前記シャドウマスクは、前記画素定義膜の材料によって構造が変わることができる。

#### 【0054】

すなわち図4bに示されたように、前記シャドウマスク 282は、前記画素定義膜の物質が陽性材料物質である場合には、開口部として予定された部分が透過領域であり、開口部以外の領域が遮断領域である構造であり、前記シャドウマスクを用いて、前記開口部として予定される部分に光を照射し、前記光の照射を受けた部分の構造が弱くなり (softening)、その後、現像工程時に、光の照射を受けた、開口部として予定される領域が除去される。

#### 【0055】

また、図示してはいないが、前記シャドウマスクは、前記画素定義膜が陰性材料物質である場合には、開口部として予定された部分が遮断領域であり、開口部以外の領域が透過領域である構造であり、前記シャドウマスクを用いて、前記開口部以外の領域に光を照射し、前記光の照射を受けた部分の構造が強くなり (hardening)、その後、現像工程時に、光の照射を受けていない、開口部として予定される領域が除去されるようになる。 30

#### 【0056】

次に、図4cに示されたように、前記シャドウマスク 282を用いて画素定義膜 281を露光 (exposing) した後、前記画素定義膜 281上にポール状スペーサ 290aを塗布する。

#### 【0057】

この際に、前記ポール状スペーサ 290aを塗布することは、スペーサディスペンサ 290を用いて塗布してもよい。

#### 【0058】

次に、前記ポール状スペーサ 290aを塗布した後、これを前記画素定義膜 281上に固定させるためのベーク工程を行う。前記ベーク工程は、50～200 温度で実行することができる。 40

#### 【0059】

図5a及び図5bは、前記ベーク工程を実行せずに、現像工程を行う場合を示す写真である。

#### 【0060】

図5aから明らかなように、現像工程を行う前には、前記ポール状スペーザが画素定義膜上に位置していたが、図5bから明らかなように、現像工程を行った後には、前記ポール状スペーザが画素定義膜上から全て除去されることが分かる。

#### 【0061】

10

20

30

40

50

図 6 a 及び図 6 b は、前記ベーク工程を実行した後、現像工程を行う場合を示す写真である。

**【 0 0 6 2 】**

図 6 a から明らかなように、現像工程を行う前には、前記ポール状スペーサが画素定義膜上に位置していることが分かり、また、図 5 b から明らかなように、現像工程を行った後にも、相変らず前記ポール状スペーサが画素定義膜上に位置していることが分かる。

**【 0 0 6 3 】**

次に、図 4 d に示されたように、前記ベーク工程を行った後、前記画素定義膜を現像して、画素定義膜上に第 1 電極の一定領域を露出させ、発光領域を定義する開口部 281 a を形成する。

10

**【 0 0 6 4 】**

前記開口部を形成することは、前記画素定義膜の物質が陽性材料物質である場合には、現像工程時に、光の照射を受けた、開口部として予定される部分の画素定義膜が除去されると共に、その上部に位置するポール状スペーサが除去され、開口部以外の領域上に位置するポール状スペーサは、相変らず画素定義膜上に存在する。

**【 0 0 6 5 】**

また、前記開口部を形成することは、前記画素定義膜が陰性材料物質である場合には、現像工程時に、光の照射を受けていない、開口部として予定される部分の画素定義膜が除去されると共に、その上部に位置するポール状スペーサが除去され、開口部以外の領域上に位置するポール状スペーサは、相変らず画素定義膜上に存在する。

20

**【 0 0 6 6 】**

次に、図 4 e に示されたように、前記第 1 電極 280 上に位置し且つ発光層を含む有機膜層 291 を形成し、次に、前記有機膜層 291 上に第 2 電極 292 を形成する。

**【 0 0 6 7 】**

前記発光層を含む有機膜層 291 は、蒸着用マスクを具備した蒸着装置を用いて形成する。この際に、蒸着装置を用いて有機膜層を形成する際に、前記ポール状スペーサは、前記蒸着用マスクが前記画素定義膜が形成された基板上に密着されて生じる蒸着用マスクの凹凸によって画素定義膜などが損傷されることを防止する役目をする。

**【 0 0 6 8 】**

前述のような本発明の有機電界発光表示装置は、第 1 電極の上部に画素定義膜を形成し、シャドウマスクを介して、開口部として予定される領域または開口部以外の領域を露光した後、ポール状スペーサを散布し、ベーク工程によってポール状スペーサを画素定義膜上に固定させた後、発光領域を定義する、開口部として予定される部分を現像することによって、開口部以外の領域にポール状スペーサを位置させ、これにより、蒸着用マスクの凹凸による画素定義膜の損傷を防止する。

30

**【 0 0 6 9 】**

したがって、本発明の有機電界発光表示装置は、従来の有機電界発光表示装置のような、スペーサパターンを形成するための写真エッチング工程を排除することができ、また、スペーサパターンを形成する工程を排除するので、第 1 電極上にスペーサフィルムの残膜が残って有機電界発光素子の性能を低下させるという問題点を解決することができる。

40

**【 0 0 7 0 】**

前記有機膜層 291 は、発光層を含み、その他、ホール注入層、ホール輸送層、電子輸送層及び電子注入層のうちいずれか 1 つ以上の層を追加に含むことができる。

**【 0 0 7 1 】**

前記ホール輸送層を形成するホール輸送性物質としては、N, N'-ジ(ナフタレン-1-イル)-N, N'-ジフェニル-ベンジジン{N, N'-di(naphthalene-1-yl)-N, N'-diphenyl-benzidine: -NPB}、N, N'-ビス(3-メチルフェニル)-[N, N'-ジフェニル-[1, 1'-ビフェニル]-4, 4'-ジアミン(TPD)]などを使用することができる。そして、ホール輸送層の膜厚は、10乃至50 nm 範囲で形成することができる。前記ホール輸送層の厚

50

さ範囲から外れる場合には、ホール注入特性が低下するので好ましくない。

【0072】

このようなホール輸送層には、ホール輸送性物質以外に電子・ホール結合に対して発光できるドーパントを付加することができ、このようなドーパントとしては、4-(ジシアノメチレン)-2-tert-ブチル-6-(1,1,7,7-テトラメチルジュロリジル-9-エニル)-4H-ピラン(4-(dicyanomethylene)-2-tert-butyl-6-(1,1,7,7-tetramethyljulolidylyl-enyl)-4H-pyran: DCJTB)、クマリン6(Coumarin 6)、ルブレン(ubrene)、DCM、DCJTB、フェリレン(Perylene)、キナクリドン(Quinacridone)などを使用し、その含量は、ホール輸送層形成用物質の総重量に対して0.1乃至5重量%を使用する。このようにホール輸送層を形成する際に、ドーパントを付加する場合、発光色をドーパントの種類及び含量によって調節可能であり、ホール輸送層の熱的安定性を改善し、素子の寿命を向上させるという利点がある。10

【0073】

また、前記ホール注入層は、スターバースト(starburst)アミン系化合物を用いて形成することができ、ホール注入層の厚さは、30乃至100nmで形成することができる。前記ホール注入層の厚さ範囲から外れる場合には、ホール注入特性が良くないので好ましくない。前記ホール注入層を介して対向電極とホール輸送層の接触抵抗を減少させ、アノード電極のホール輸送能力を向上させて、素子の特性が全般的に改善される効果を得ることができる。20

【0074】

本発明の発光層の形成材料は、特に限定されず、具体的な例として、CBP(4,4'-bis(carbazol-9-yl)-biphenyl)を挙げることができる。

【0075】

本発明の発光層は、上述したホール輸送層と同様に、電子・ホール結合に対して発光できるドーパントをさらに含有することができ、この際に、ドーパントの種類及び含量は、ホール輸送層の場合とほぼ同じ水準であり、前記発光層の膜厚は、10乃至40nm範囲であることが好ましい。

【0076】

前記電子輸送層を形成する電子輸送性物質としては、トリス(8-キノリノラト)-アルミニウム(tris(8-quinolinolate)-aluminum: Alq3)、Almq3を使用し、上述したホール輸送層と同様に電子・ホール結合に対して発光できるドーパントをさらに含有してもよい。この際に、ドーパントの種類及び含量は、ホール輸送層の場合とほぼ同じ水準であり、前記電子輸送層の膜厚は、30乃至100nm範囲にすることができる。前記電子輸送層の厚さ範囲から外れる場合には、効率が低下し、駆動電圧が上昇するので、好ましくない。30

【0077】

前記発光層と電子輸送層との間には、ホール障壁層(HBL)がさらに形成されることがある。ここで、ホール障壁層は、りん光発光物質で形成される励起子が電子輸送層へ移動することを防止したり、ホールが電子輸送層へ移動することを防止する役目をするものであって、前記ホール障壁層の形成材料としてBA1qを使用することができます。40

【0078】

前記電子注入層は、LiFからなる物質で形成することができ、その厚さは、0.1乃至10nm範囲で形成することができる。前記電子注入層の厚さ範囲から外れる場合には、駆動電圧が上昇するので、好ましくない。

【0079】

前記有機膜層の上部に形成された第2電極292は、背面発光型である場合、反射型で構成され、反射型で構成される場合、Li、Ca、LiF/Ca、LiF/Al、Al、Mg及びこれらの合金よりなる群から選択されるいずれか1つの物質で形成することができます50

きる。

### 【0080】

また、前記有機膜層の上部に形成された第2電極292は、前面発光型である場合、半透過カソード型、または半透過カソードの形成後、透過型カソード型を積層した構造で構成される。前記半透過カソード型は、Li、Ca、LiF/Ca、LiF/Al、Al、Mg及びMg合金よりなる群から選択されるいずれか1つの物質を使用してこれを5乃至30nmの厚さで薄く形成して構成することができる。また、前記半透過カソードの形成後、透過型カソード型を構成する方法は、仕事関数が小さい金属、すなわちLi、Ca、LiF/Ca、LiF/Al、Al、Mg及びMg合金よりなる群から選択されるいずれか1つの物質を使用して半透過型カソードを形成した後、低抵抗特性を有するITO、IZOを使用した膜を追加的に形成する。この際に、半透過カソードの厚さが5nm未満である場合には、低電圧で電子注入をすることができない、仮に半透過カソードの厚さが30nm以上である場合には、透過率が顕著に低下するので好ましくない。また、半透過カソードと透過型カソードとを合わせた総厚さは、10乃至400nmの厚さが適当である。

### 【0081】

以上において説明した本発明は、本発明が属する技術の分野における通常の知識を有する者であれば、本発明の技術的思想を逸脱しない範囲内で、様々な置換、変形及び変更が可能であるので、上述した実施形態及び添付された図面に限定されるものではない。

### 【図面の簡単な説明】

### 【0082】

【図1】蒸着用マスクを具備した蒸着装置を概略的に示す断面図である。

【図2a】従来の有機電界発光表示装置の製造方法を説明する断面図である。

【図2b】従来の有機電界発光表示装置の製造方法を説明する断面図である。

【図3】有機電界発光表示装置の単位画素を示す平面図である。

【図4a】本発明の実行例に係る有機電界発光表示装置の製造方法を示す断面図である。

【図4b】本発明の実行例に係る有機電界発光表示装置の製造方法を示す断面図である。

【図4c】本発明の実行例に係る有機電界発光表示装置の製造方法を示す断面図である。

【図4d】本発明の実行例に係る有機電界発光表示装置の製造方法を示す断面図である。

【図4e】本発明の実行例に係る有機電界発光表示装置の製造方法を示す断面図である。

【図5a】ベーク工程を実行せずに現像(developing)工程を行う場合を示す写真である。

【図5b】ベーク工程を実行せずに現像(developing)工程を行う場合を示す写真である。

【図6a】ベーク工程を実行した後に現像(developing)工程を行う場合を示す写真である。

【図6b】ベーク工程を実行した後に現像(developing)工程を行う場合を示す写真である。

### 【符号の説明】

### 【0083】

200 基板

210 バッファ層

220a ソース領域

220b ドレイン領域

221 チャネル領域

230 ゲート絶縁膜

231 ゲート電極

240 層間絶縁膜

150a ソース電極

150b ドレイン電極

260 無機膜

10

20

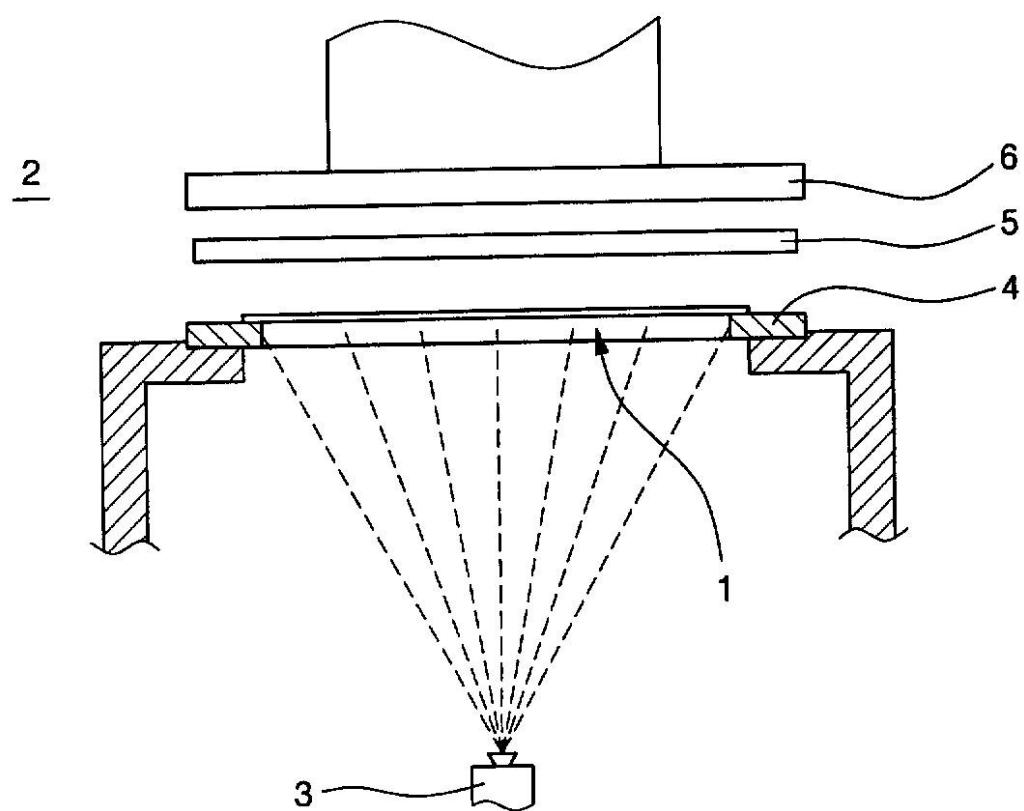
30

40

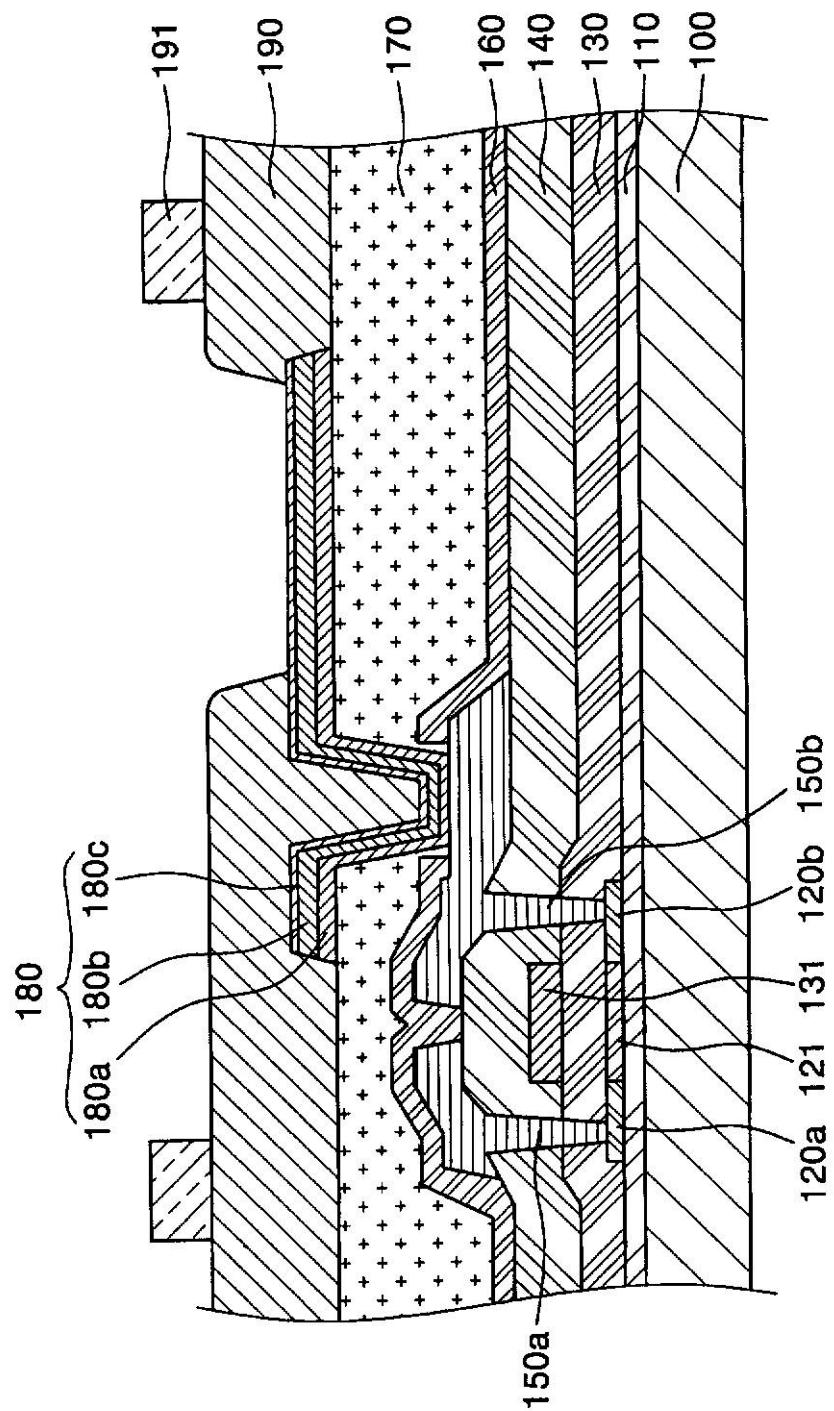
50

270 有機膜  
280 第1電極  
281 画素定義膜  
290 スペーサディスペンサ  
290a ボール状スペーサ  
291 有機膜層  
292 第2電極

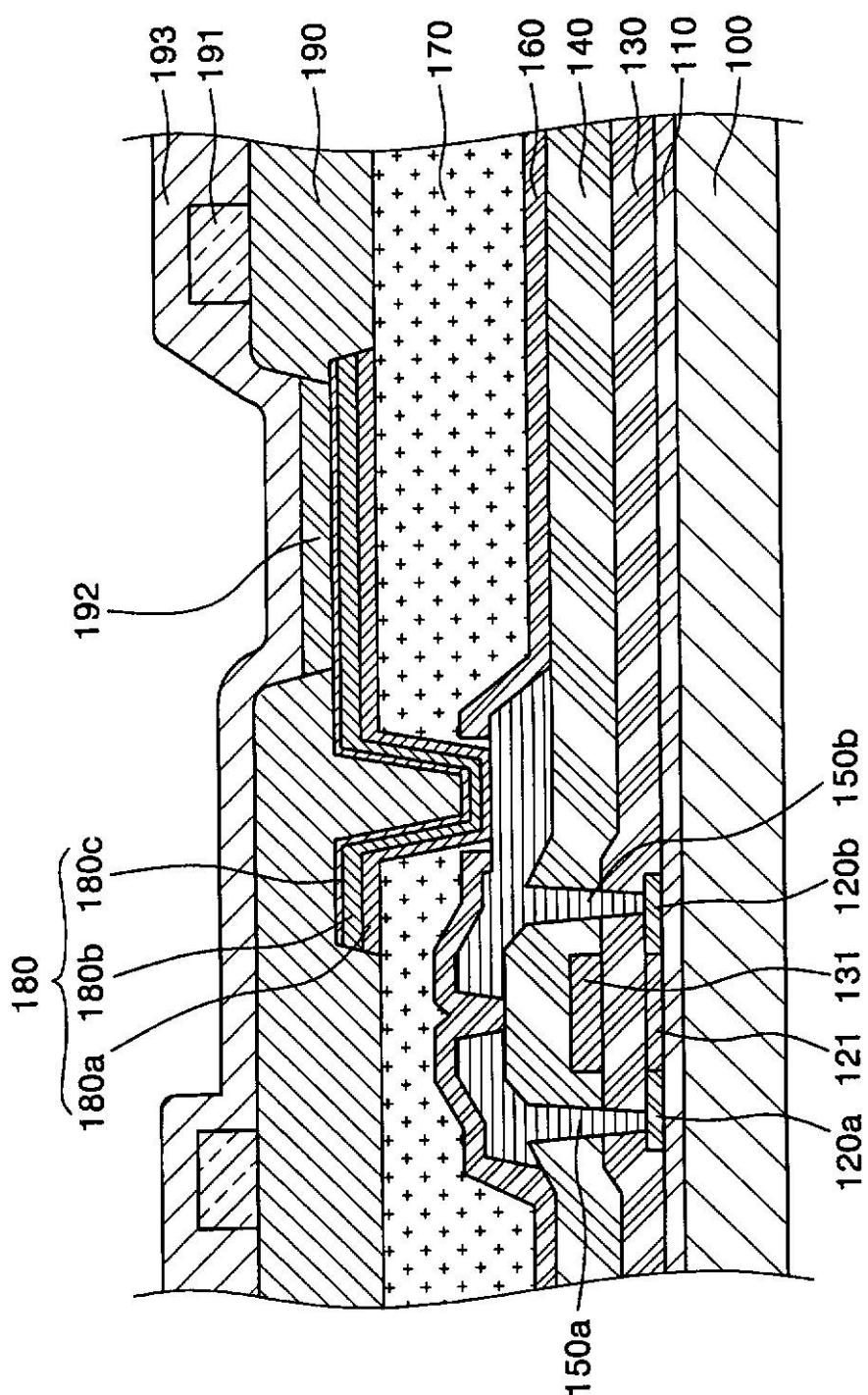
【図1】



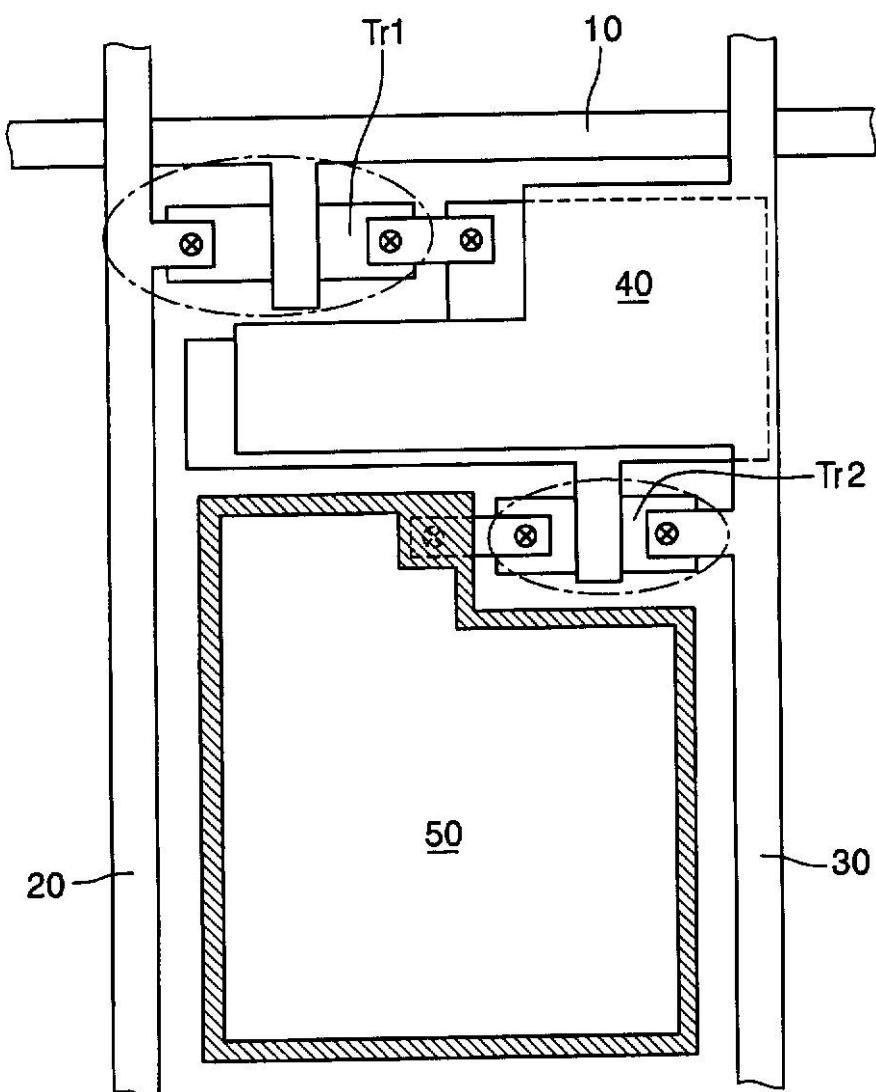
【図 2 a】



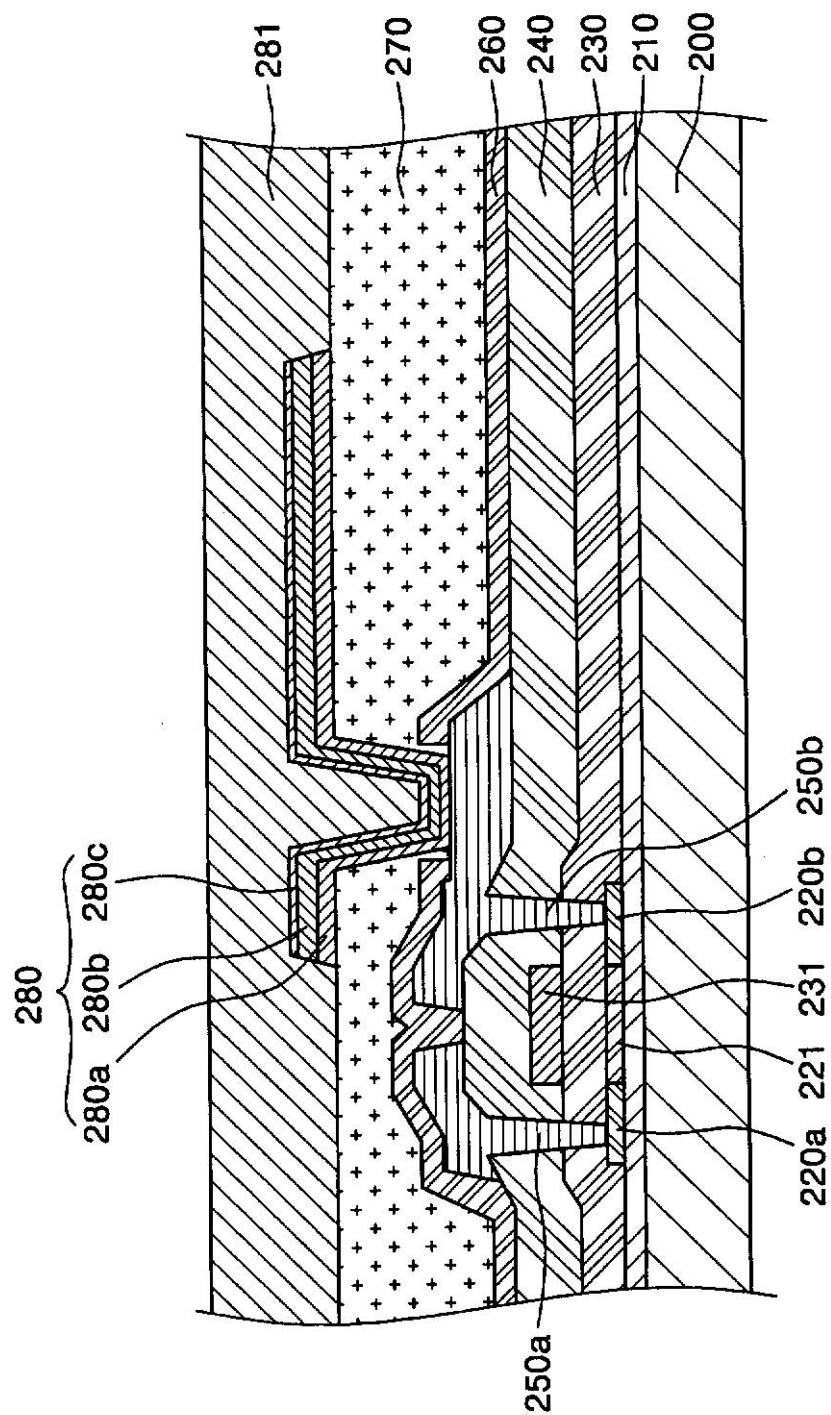
【図 2 b】



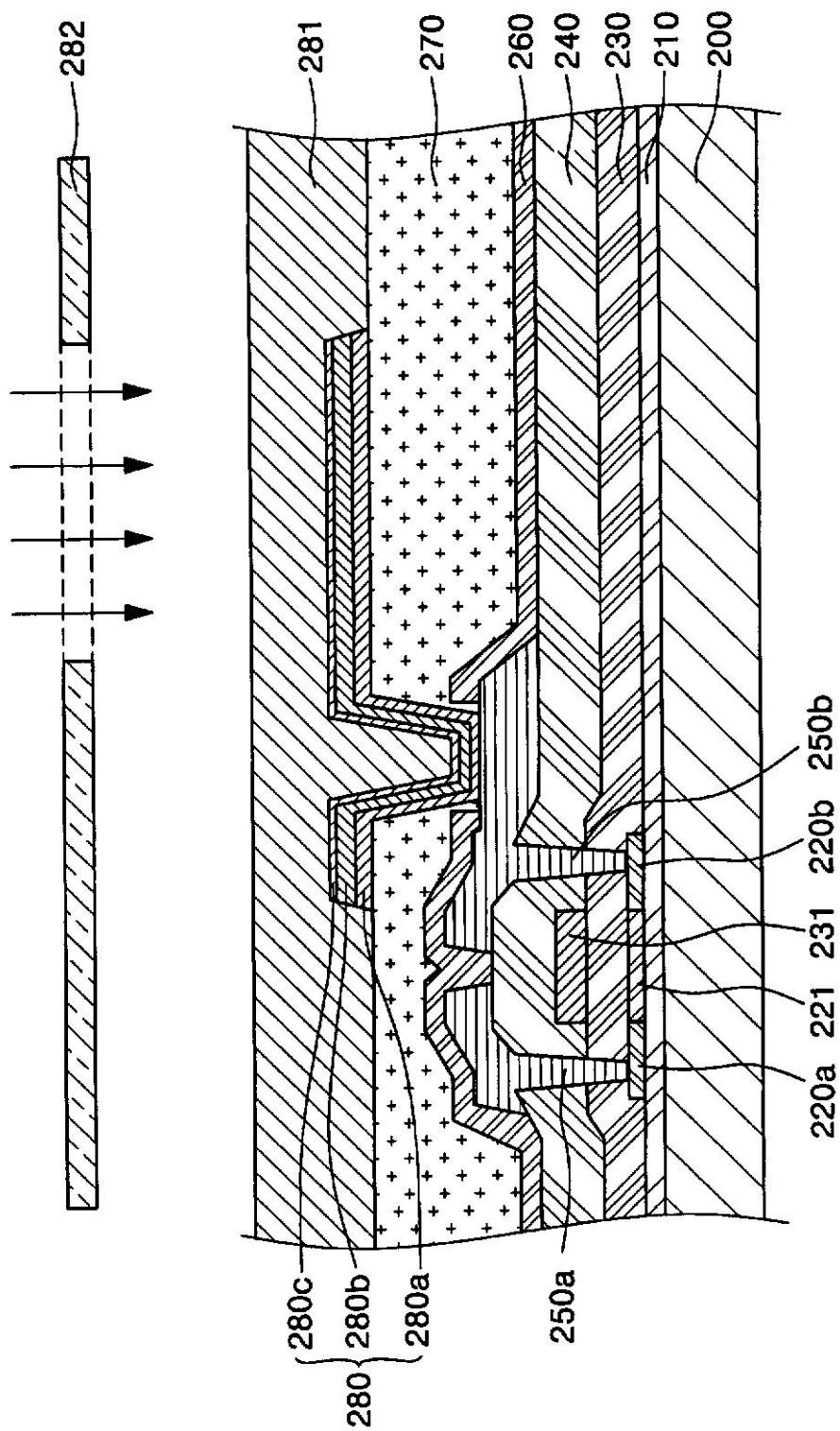
【図3】



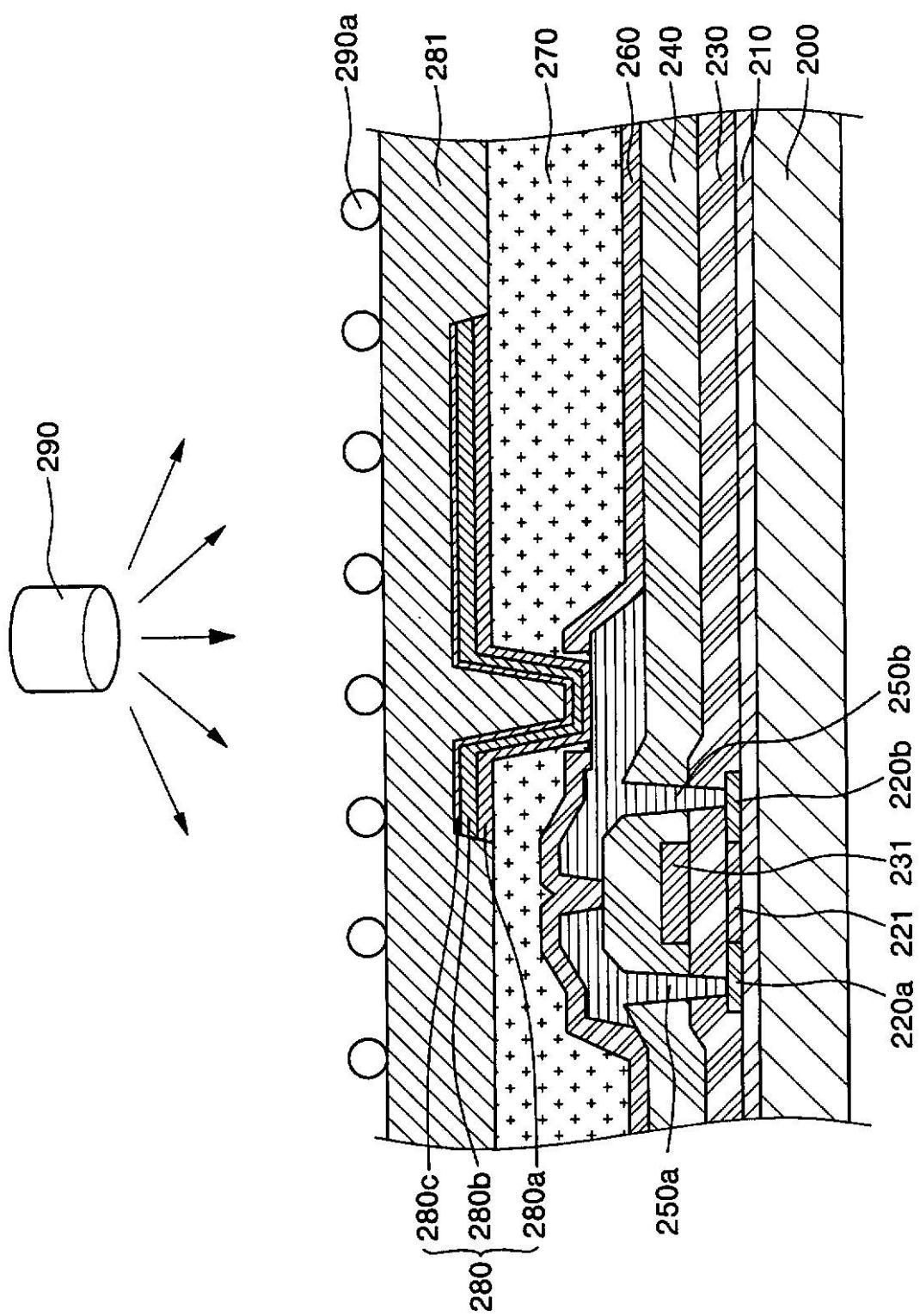
【図4a】



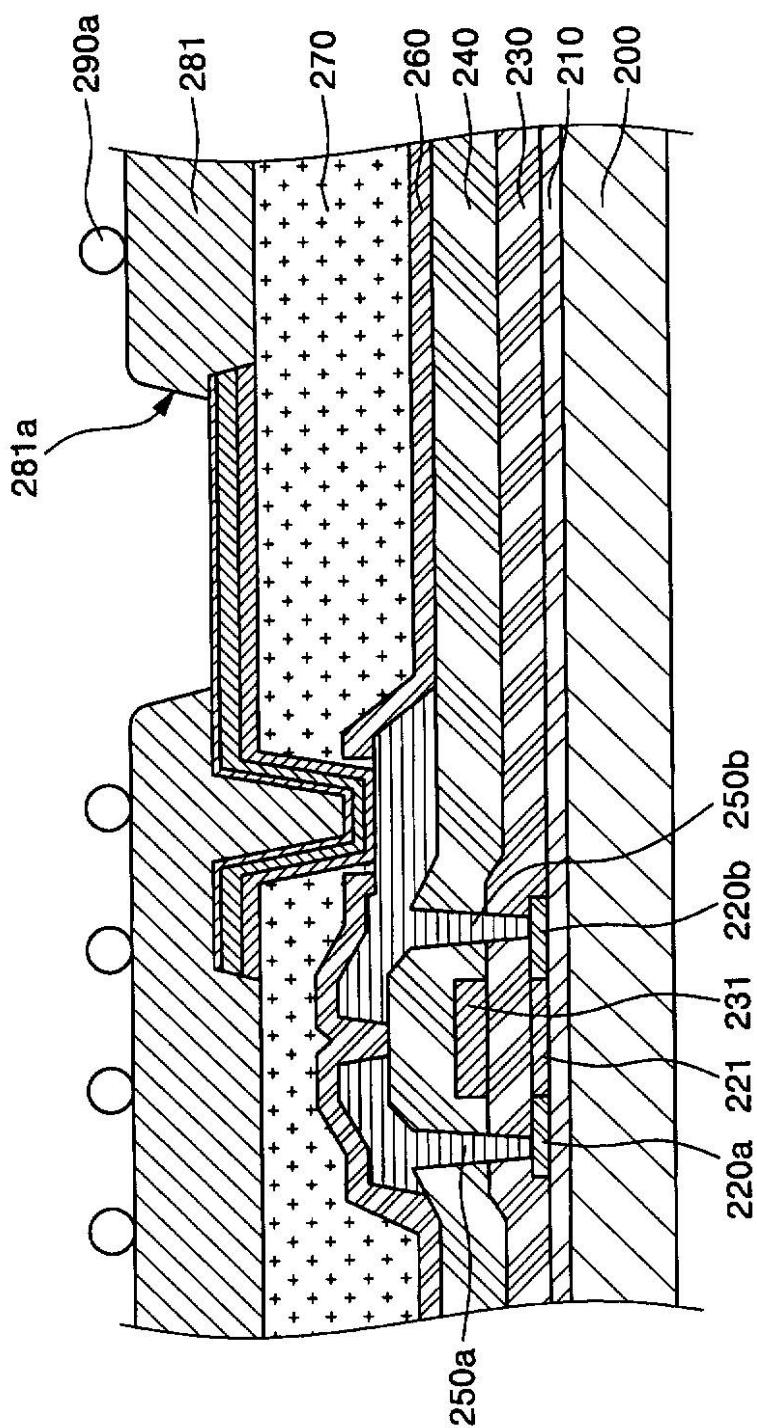
【図 4 b】



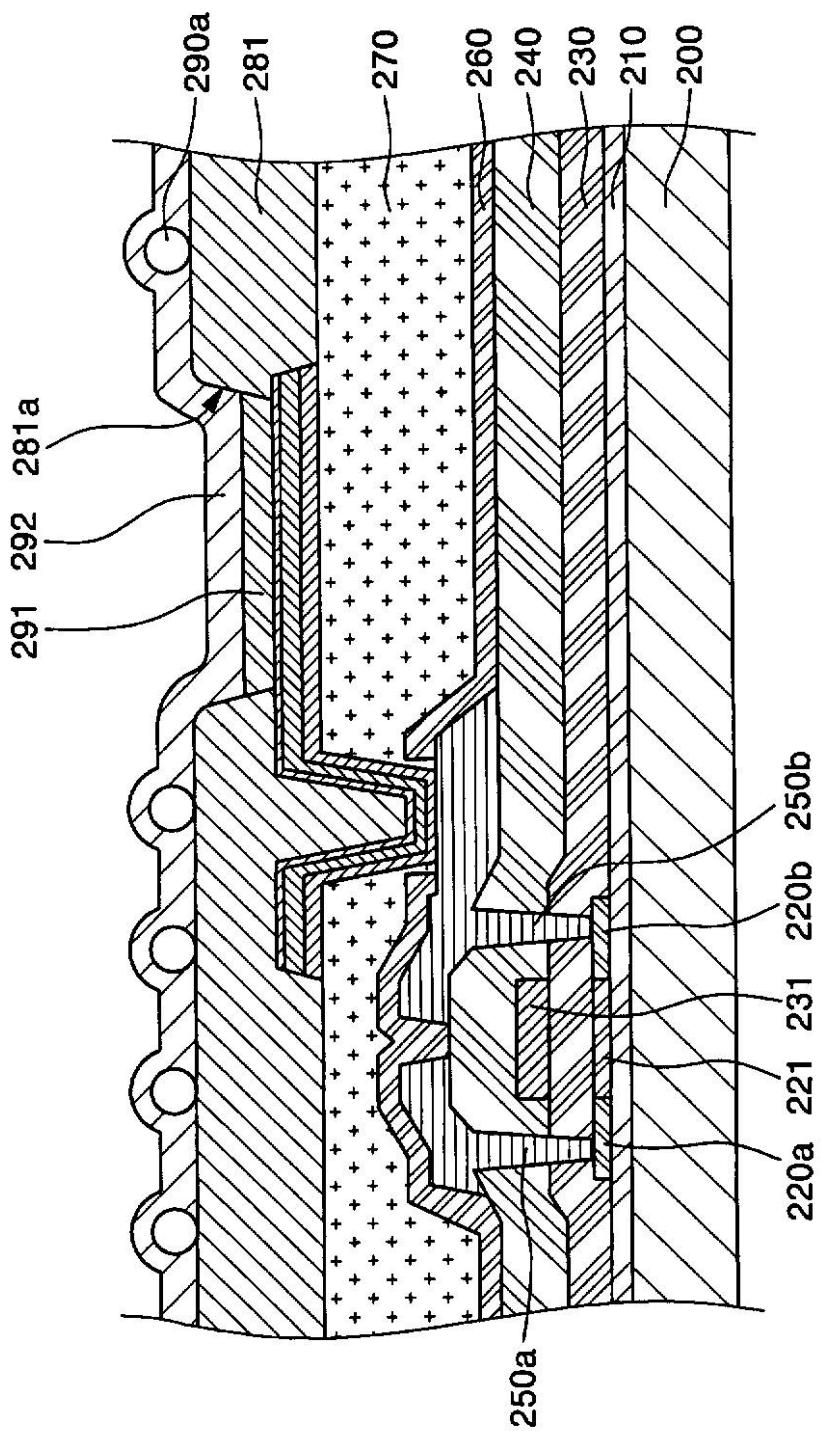
【図4c】



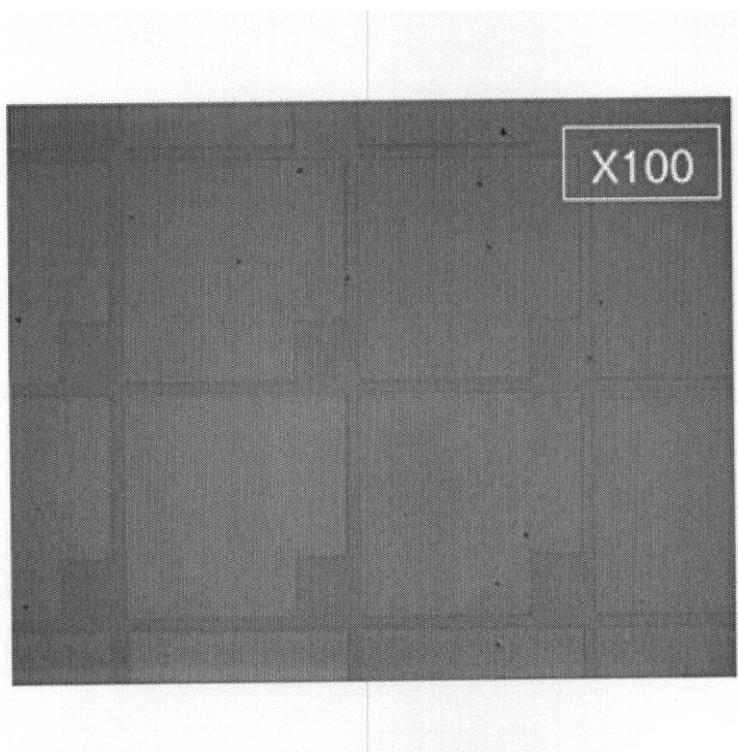
【図4d】



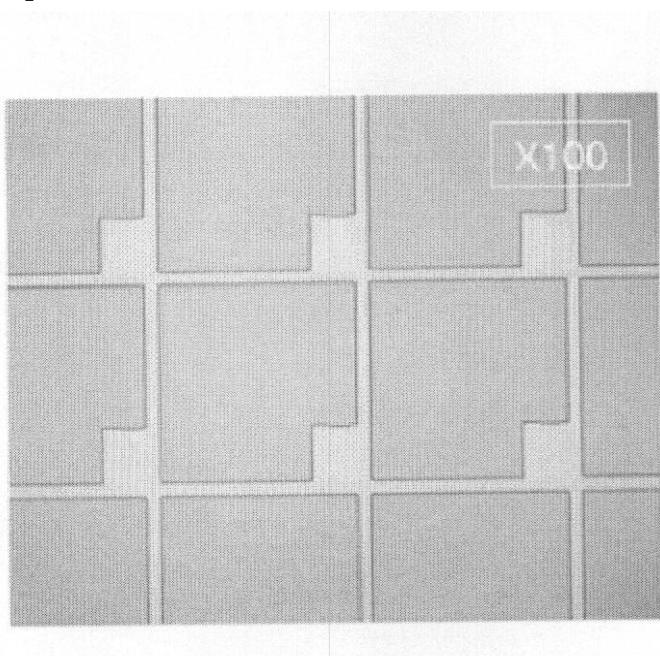
【図4e】



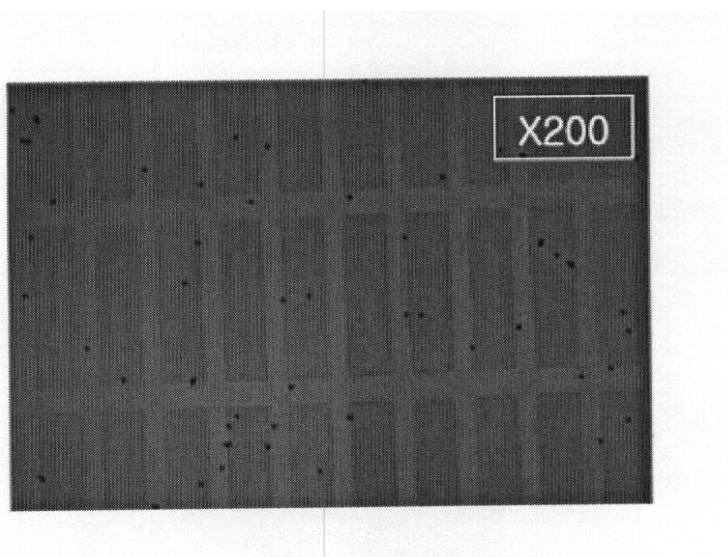
【図 5 a】



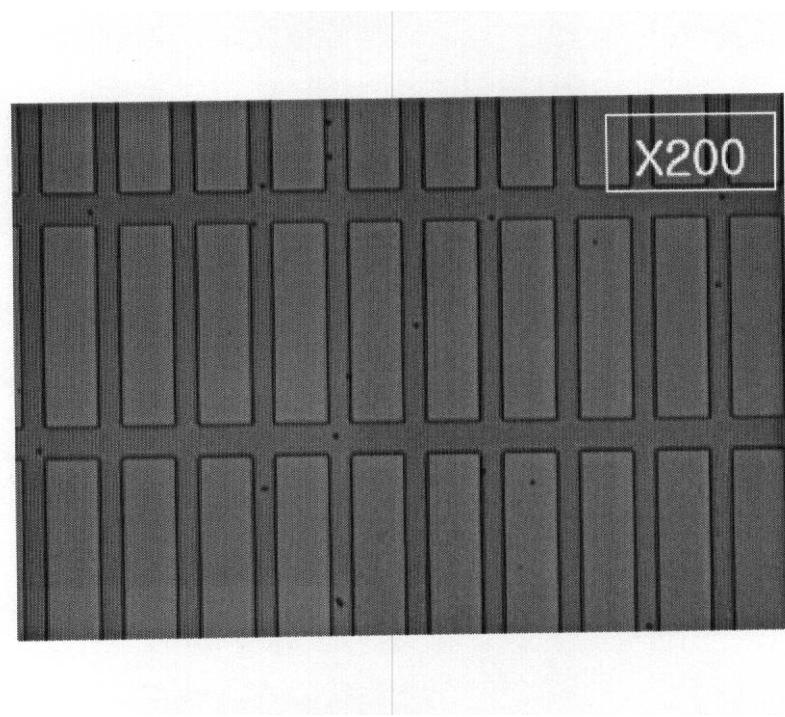
【図 5 b】



【図 6 a】



【図 6 b】



---

フロントページの続き

(51)Int.Cl.	F I	テーマコード(参考)
H 05B 33/12 (2006.01)	H 05B 33/26	Z
H 01L 51/50 (2006.01)	H 05B 33/12	B
H 05B 33/10 (2006.01)	H 05B 33/14	A
	H 05B 33/10	

F ターム(参考) 3K107 AA01 BB01 CC45 DD22 DD23 DD24 DD27 DD28 DD29 DD44X  
DD44Y DD45X DD45Y DD46X DD46Y DD89 DD96 EE03 FF15 GG04  
GG06 GG11  
5C094 AA36 BA27 DA13 EA04 EC10 GB10

专利名称(译)	有机电致发光显示装置及其制造方法		
公开(公告)号	<a href="#">JP2008166258A</a>	公开(公告)日	2008-07-17
申请号	JP2007271736	申请日	2007-10-18
[标]申请(专利权)人(译)	三星斯笛爱股份有限公司		
申请(专利权)人(译)	三星工スディアイ株式会社		
[标]发明人	權正鉉		
发明人	權 正鉉		
IPC分类号	H05B33/22 G09F9/30 H01L27/32 H05B33/28 H05B33/26 H05B33/12 H01L51/50 H05B33/10		
CPC分类号	H01L27/3244 H01L27/3246 H01L51/0011 H01L51/5218 H01L2251/558		
FI分类号	H05B33/22.Z G09F9/30.338 G09F9/30.365.Z G09F9/30.349.Z H05B33/28 H05B33/26.Z H05B33/12.B H05B33/14.A H05B33/10 G09F9/30.365 H01L27/32		
F-TERM分类号	3K107/AA01 3K107/BB01 3K107/CC45 3K107/DD22 3K107/DD23 3K107/DD24 3K107/DD27 3K107/DD28 3K107/DD29 3K107/DD44X 3K107/DD44Y 3K107/DD45X 3K107/DD45Y 3K107/DD46X 3K107/DD46Y 3K107/DD89 3K107/DD96 3K107/EE03 3K107/FF15 3K107/GG04 3K107/GG06 3K107/GG11 5C094/AA36 5C094/BA27 5C094/DA13 5C094/EA04 5C094/EC10 5C094/GB10		
代理人(译)	渡边 隆 村山彥		
优先权	1020070001027 2007-01-04 KR		
其他公开文献	<a href="#">JP5026221B2</a>		
外部链接	<a href="#">Espacenet</a>		

### 摘要(译)

要解决的问题：提供一种有机电致发光显示装置，其可以省去用于形成间隔物图案的光刻工艺并提供其制造方法。SOLUTION：有机电致发光显示装置，具有基板，位于基板上的第一电极，设置在第一电极上的像素限定膜，具有开口部和闭口部，大量球形位于像素限定膜的封闭口部分上的间隔物，位于第一电极上部的有机膜层，包括位于有机物上部的发光层和第二电极电影层。有机电致发光显示器的制造方法包括制备基板的步骤，在基板上形成第一电极的步骤，在第一电极的上部形成像素限定膜的步骤，在像素限定膜的上部涂覆球形间隔物的步骤，其中形成开口部分以暴露第一电极的一部分并限定发光区域的步骤，其中步骤有机薄膜层位于第一电极的上部并包含发光层，以及台阶，其中第二电极形成在有机薄膜层的上部。

